

Реєстраційна картка НДДКР

Державний реєстраційний номер: 0125U001911

Відкрита

Дата реєстрації: 28-03-2025

Статус виконавця: 17 - головний виконавець



1. Загальні відомості

Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

КПКВК: 2201300

Напрямок фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 3982.335

У тому числі по роках (тис. грн.):

Рік	Фінансування
2025	3982.335

2. Замовник

Назва організації: Національний фонд досліджень України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 42734019

Адреса: вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, 01001, Україна

Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України

Телефон: 380442981622

Телефон: 380442981622

3. Виконавець

Назва організації: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070944

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Адреса: вул. Володимирська, буд. 60, м. Київ, 01033, Україна

Телефон: 380442393333

Телефон: 380442393230

E-mail: office@knu.ua

WWW: <http://www.univ.kiev.ua>

WWW: <https://knu.ua>

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Генерація та рекомбінація нерівноважних носіїв заряду в сполуках GeSn

Назва роботи (англ)

Generation and recombination of non-equilibrium charge carriers in GeSn alloys

Мета роботи (укр)

Встановлення перебігу процесів рекомбінації носіїв заряду і переносу енергії фотозбудження в сполуках GeSn, що дозволить набути фундаментальні знання, необхідні для прикладного застосування в оптоелектроніці для реєстрації випромінювання ближнього інфрачервоного діапазону. Будуть створені наукові основи керування часовими і спектральними характеристиками фоточутливості залежно від вмісту олова, ступеня структурного розупорядкування, величин деформацій, наявності глибоких рівнів дефектів.

Мета роботи (англ)

Establishing the processes of charge carrier recombination and energy transfer of photoexcitation in GeSn compounds will enable the acquisition of fundamental knowledge necessary for practical applications in optoelectronics for near-infrared radiation detection. Scientific foundations will be developed for controlling the temporal and spectral characteristics of photosensitivity depending on the tin content, degree of structural disorder, magnitude of strain, and presence of deep defect levels.

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Нові речовини і матеріали

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Вид роботи: 39 - фундаментальна

Очікувані результати: Методи, теорії

Галузь застосування: 72. Наукові дослідження та розробки

6. Етапи виконання

Номер	Початок	Закінчення	Звітний документ	Назва етапу
2	03.2025	11.2025	Остаточний звіт	Швидкий термічний відпал та обробка сполук GeSn високоенергетичними світловими імпульсами

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 45.09.35

Індекс УДК: 621.315.562

8. Заключні відомості

Керівник організації:

Толстанова Ганна Миколаївна (д. б. н., професор)

Керівники роботи:

Кондратенко Сергій Вікторович (д. ф.-м. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Бойко С.І. (Тел.: +38 (044) 239-31-88)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ



Юрченко Т.А.